

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC

191-2T

Première édition
First edition
1996-12

Dix-huitième complément à la Publication 191-2 (1966)

**Normalisation mécanique des dispositifs
à semiconducteurs**

**Partie 2:
Dimensions**

Eighteenth supplement to Publication 191-2 (1966)

**Mechanical standardization of semiconductor
devices**

**Part 2:
Dimensions**

*Les feuilles de ce complément sont à insérer dans la
Publication 191-2*

*The sheets contained in this supplement are to be
inserted in Publication 191-2*



CODE PRIX
PRICE CODE

B

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD

**CEI
IEC**

191-2

Première édition
First edition
1996-12

Modifiée selon les Compléments:
Amended in accordance with Supplement:
A (1967), B (1969), C (1970), D (1971), E (1974),
F (1976), G (1978), H (1978), J (1980), K (1981),
L (1982), M (1983), N (1987), P (1988), Q (1990)
R (1995), S (1995) et/and T(1996)

Dix-huitième complément à la Publication 191-2 (1966)

Normalisation mécanique des dispositifs à semiconducteurs

Partie 2: Dimensions

Eighteenth supplement to Publication 191-2 (1966)

Mechanical standardization of semiconductor devices

Part 2: Dimensions

© CEI 1996 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé,
électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les
microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized
in any form or by any means, electronic or mechanical,
including photocopying and microfilm, without permission
in writing from the publisher

Bureau central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembe Genève Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

INSTRUCTIONS POUR L'INSERTION DES
NOUVELLES PAGES DANS LA CEI 191-2

Remplacer la page de titre existante par la
nouvelle page de titre.

Retirer la page 191 IEC 1 existante et la
remplacer par la nouvelle page 191 IEC 1.

Chapitre I:

Ajouter les nouvelles feuilles suivantes:

191 IEC I-083B-a
191 IEC I-083B-b
191 IEC I-084F-a
191 IEC I-084F-b

INSTRUCTIONS FOR THE INSERTION
OF NEW PAGES IN IEC 191-2

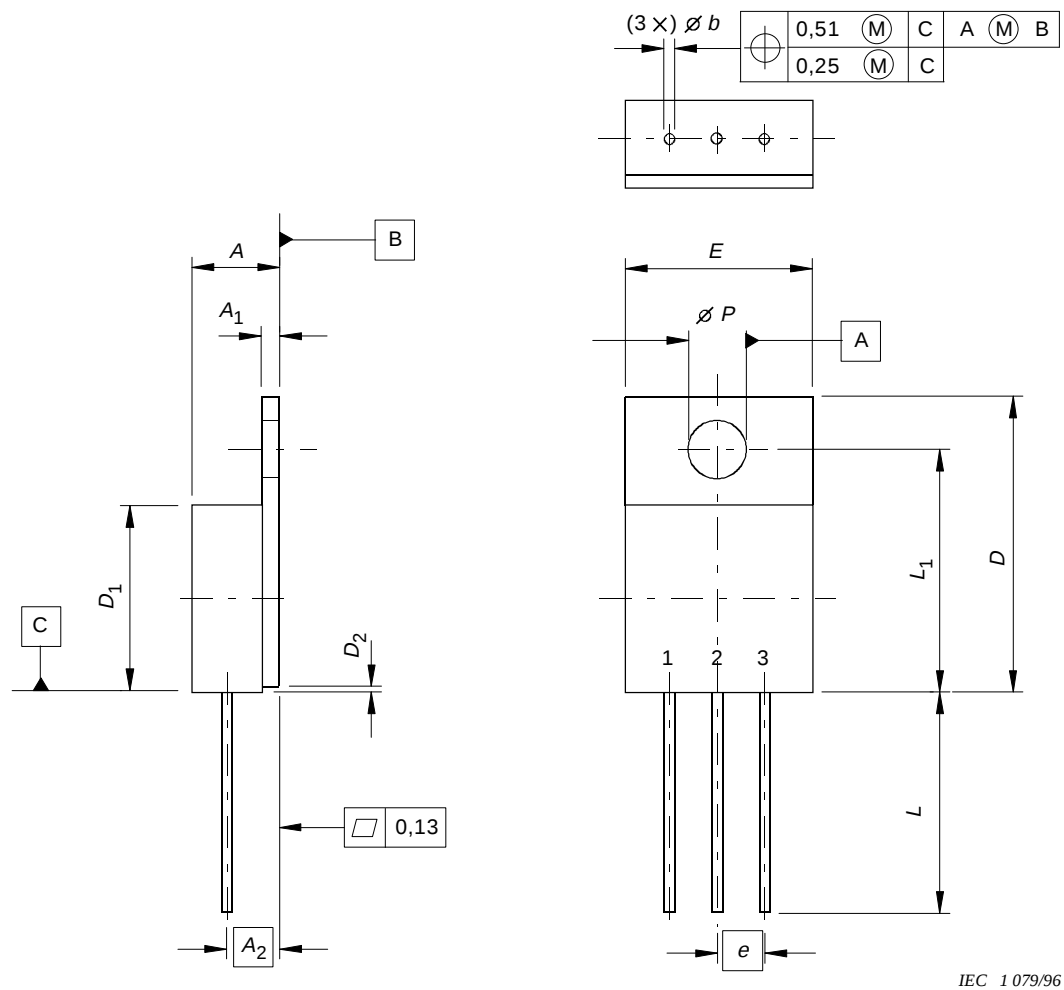
Replace the existing title page with the
new title page.

Remove the existing page 191 IEC 1 and
insert in its place the new page 191 IEC 1.

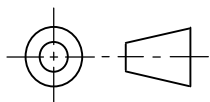
Chapter I:

Add the following new sheets:

191 IEC I-083B-a
191 IEC I-083B-b
191 IEC I-084F-a
191 IEC I-084F-b



IEC 1 079/96



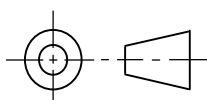
Famille de boîtiers à radiateur monté sur le flanc (sorties périphériques) avec une distance de 0,100 inches entre broches

Flange mounted header family (peripheral terminals) 0,100 inch lead spacing

Date: 1996

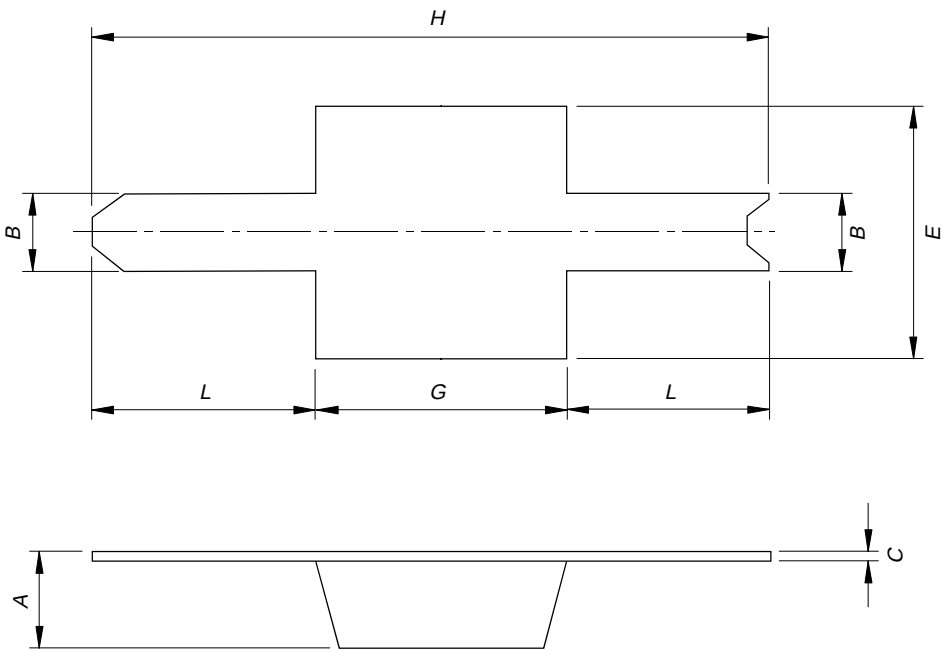
Toutes les dimensions sont données en millimètres All dimensions in millimetres								
	Type AA		Type AB		Type AC		Type AD	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
<i>A</i>	4,83	5,33	4,83	5,33	4,83	5,33	4,83	5,33
<i>A</i> ₁	0,89	1,14	0,64	0,89	0,64	0,89	0,89	1,14
<i>A</i> ₂	3,05*		2,79*		2,79*		3,05*	
$\varnothing b$	0,64	0,89	0,89	1,14	0,64	0,89	0,89	1,14
<i>D</i>	16,38	16,89	16,38	16,89	16,38	16,89	16,38	16,89
<i>D</i> ₁	10,41	10,92	10,41	10,92	10,41	10,92	10,41	10,92
<i>D</i> ₂	—	0,97	—	0,51	—	0,97	—	0,97
<i>e</i>	2,54*		2,54*		2,54*		2,54*	
<i>E</i>	10,41	10,67	10,41	10,92	10,41	10,67	10,41	10,67
<i>L</i>	12,70	19,05	12,70	14,73	12,70	19,05	12,70	19,05
<i>L</i> ₁	13,39	13,64	13,21	13,72	13,39	13,64	13,39	13,64
$\varnothing P$	3,56	3,81	3,56	3,81	3,56	3,81	3,56	3,81

* Position exacte



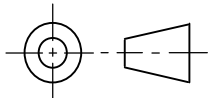
Famille de boîtiers à radiateur monté
sur le flanc (sorties périphériques) avec
une distance de 0,100 inches entre broches
Flange mounted header family (peripheral
terminals) 0,100 inch lead spacing

Date: 1996



IEC 1 080/96

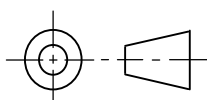
Référence Reference	Type 1		Type 2		Notes
	Min. mm	Max. mm	Min. mm	Max. mm	
A	—	0,05	—	0,05	1
B	0,08	0,14	0,08	0,14	2
C	0,003	—	0,003	—	3
E	0,25	0,32	0,165	0,30	
G	0,25	0,32	0,21	0,30	
H	0,78	0,84	0,65	0,72	
L	0,22	0,32	0,17	0,25	



Diodes hyperfréquences
à sorties à poutres
Microwave beam lead diode

Date: 1996

- | | |
|--|--|
| <p>1 La valeur de cette dimension est déterminée par les tolérances du procédé, cependant elle ne doit pas dépasser la valeur maximale indiquée.</p> <p>2 Les extrémités des broches sont formées en vue de leur identification, la sortie en pointe est la cathode et la sortie crantée est l'anode. Le degré de mise en forme dépend de la tolérance du procédé de découpe de la sortie.</p> <p>3 La valeur minimale indiquée de cette dimension est l'épaisseur minimale de broche requise pour répondre aux exigences de solidité des sorties.</p> | <p>1 The value of this dimension is determined by process tolerances, however, it will not exceed the maximum value quoted.</p> <p>2 The ends of the leads are shaped for identification purposes, the "pointed" lead is the cathode and the "notched" lead the anode. The degree of shaping is dependent upon the tolerances of the etching process used to shape the lead.</p> <p>3 The minimum value of this dimension quoted is the minimum thickness of lead required to meet lead strength requirements.</p> |
|--|--|



Diodes hyperfréquences
à sorties à poutres
Microwave beam lead diode

Date: 1996

Publications de la CEI préparées par le Comité d'Etudes n° 47

- 191:—Normalisation mécanique des dispositifs à semi-conducteurs.
- 191-1 (1966) Première partie: Préparation des dessins des dispositifs à semiconducteurs.
- 191-1A (1969) Premier complément.
- 191-1B (1970) Deuxième complément.
- 191-1C (1974) Troisième complément.
- 191-2 (1966) Partie 2: Dimensions – Réimpression consolidée comprenant la CEI 191-2A (1967), 191-2B (1969), 191-2C (1970), 191-2D (1971), 191-2E (1974), 191-2F (1976), 191-2G (1978), 191-2H (1978), 191-2J (1980), 191-2K (1981), 191-2L (1982), 191-2M (1983), 191-2N (1987), 191-2P (1988), 191-2Q (1990), 191-2R (1995), 191-2S (1995), 191-2T (1996).
- 191-3 (1974) Troisième partie: Règles générales pour la préparation des dessins d'encombrement des circuits intégrés.
Modification n° 1 (1983).
Amendement 2 (1995).
- 191-3A (1976) Premier complément.
- 191-3B (1978) Deuxième complément.
- 191-3C (1987) Troisième complément.
- 191-3D (1988) Quatrième complément.
- 191-3E (1990) Cinquième complément.
- 191-3F (1994) Sixième complément.
- 191-4 (1987) Quatrième partie: Système de codification et classification en formes des boîtiers pour dispositifs à semiconducteurs.
- 191-5 (1987) Cinquième partie: Recommandations applicables au transfert automatique sur bande (TAB) des circuits intégrés.
- 191-6 (1990) Sixième partie: Règles générales pour la préparation des dessins d'encombrement des dispositifs à semiconducteurs à montage en surface.
- 747:— Dispositifs à semiconducteurs. Dispositifs discrets.
- 747-1 (1983) Première partie: Généralités.
Amendement 1 (1991).
Amendement 2 (1993).
Amendement 3 (1996).
- 747-2 (1983) Deuxième partie: Diodes de redressement.
Amendement 1 (1992).
Amendement 2 (1993).
- 747-2-1 (1989) Section un: Spécification particulière-cadre pour les diodes de redressement (y compris les diodes à avalanche) à température ambiante et de boîtier spécifiées, pour courants jusqu'à 100 A.
- 747-2-2 (1993) Section 2: Spécification particulière cadre pour les diodes de redressement (y compris les diodes à avalanche), à températures ambiante et de boîtier spécifiées, pour courants supérieurs à 100 A.
- 747-3 (1985) Troisième partie: Diodes de signal (y compris les diodes de commutation) et diodes régulatrices.
Amendement 1 (1991).
Amendement 2 (1993).
- 747-3-1 (1986) Section un: Spécification particulière cadre pour les diodes de signal, les diodes de commutation et les diodes à avalanche contrôlée.
- 747-3-2 (1986) Section deux: Spécification particulière cadre pour les diodes régulatrices de tension et les diodes de tension de référence, à l'exclusion des diodes de référence de précision compensées en température.
- 747-4 (1991) Quatrième partie: Diodes et transistors hyperfréquences.
Amendement 1 (1993).
- 747-5 (1992) Cinquième partie: Dispositifs optoélectroniques.
Amendement 1 (1994).
Amendement 2 (1995).

(suite)

IEC publications prepared by Technical Committee No. 47

- 191:— Mechanical standardization of semiconductor devices.
- 191-1 (1966) Part 1: Preparation of drawings of semi-conductor devices.
- 191-1A (1969) First supplement.
- 191-1B (1970) Second supplement.
- 191-1C (1974) Third supplement.
- 191-2 (1966) Part 2: Dimensions – Consolidated reprint consisting of IEC 191-2A (1967), 191-2B (1969), 191-2C (1970), 191-2D (1971), 191-2E (1974), 191-2F (1976), 191-2G (1978), 191-2H (1978), 191-2J (1980), 191-2K (1981), 191-2L (1982), 191-2M (1983), 191-2N (1987), 191-2P (1988), 191-2Q (1990), 191-2R (1995), 191-2S (1995), 191-2T (1996).
- 191-3 (1974) Part 3: General rules for the preparation of outline drawings of integrated circuits.
Amendment No. 1 (1983).
Amendment 2 (1995).
- 191-3A (1976) First supplement.
- 191-3B (1978) Second supplement.
- 191-3C (1987) Third supplement.
- 191-3D (1988) Fourth supplement.
- 191-3E (1990) Fifth supplement.
- 191-3F (1994) Sixth supplement.
- 191-4 (1987) Part 4: Coding system and classification into forms of package outlines for semiconductor devices.
- 191-5 (1987) Part 5: Recommendations applying to tape automated bonding (TAB) of integrated circuits.
- 191-6 (1990) General rules for the preparation of outline drawings of surface mounted semiconductor device packages.
- 747:— Semiconductor devices. Discrete devices.
- 747-1 (1983) Part 1: General.
Amendment 1 (1991).
Amendment 2 (1993).
Amendment 3 (1996).
- 747-2 (1983) Part 2: Rectifier diodes.
Amendment 1 (1992).
Amendment 2 (1993).
- 747-2-1 (1989) Section One: Blank detail specification for rectifier diodes (including avalanche rectifier diodes), ambient and case-rated up to 100 A.
- 747-2-2 (1993) Section 2: Blank detail specification for rectifier diodes (including avalanche rectifier diodes), ambient and case-rated, for currents greater than 100 A.
- 747-3 (1985) Part 3: Signal (including switching) and regulator diodes.
Amendment 1 (1991).
Amendment 2 (1993).
- 747-3-1 (1986) Section One: Blank detail specification for signal diodes, switching diodes and controlled-avalanche diodes.
- 747-3-2 (1986) Section Two: Blank detail specification for voltage-regulator diodes and voltage-reference diodes, excluding temperature-compensated precision reference diodes.
- 747-4 (1991) Part 4: Microwave diodes and transistors.

Amendment 1 (1993).
- 747-5 (1992) Part 5: Optoelectronic devices.
Amendment 1 (1994).
Amendment 2 (1995).

(continued)

Publications de la CEI préparées par le Comité d'Etudes n° 47 (suite)

- 747-6 (1983) Sixième partie: Thyristors.
Amendement 1 (1991).
Amendement 2 (1994).
- 747-6-1 (1989) Section un: Spécification particulière cadre pour les thyristors triodes bloqués en inverse, à température ambiante et de boîtier spécifiée, pour courants jusqu'à 100 A.
- 747-6-2 (1991) Section deux: Spécification particulière cadre pour les thyristors triodes bidirectionnels (triacs), à température ambiante ou à température de boîtier spécifiée, jusqu'à 100 A.
- 747-6-3 (1993) Section trois: Spécification particulière cadre pour les thyristors triodes bloqués en inverse, à température ambiante et de boîtier spécifiée, pour courants supérieurs à 100 A.
- 747-7 (1988) Septième partie: Transistors bipolaires.
Amendement 1 (1991).
Amendement 2 (1994).
- 747-7-1 (1989) Section un: Spécification particulière cadre pour les transistors bipolaires à température ambiante spécifiée pour amplification en basse et haute fréquences.
- 747-7-2 (1989) Section deux: Spécification particulière cadre pour les transistors bipolaires à température de boîtier spécifiée pour amplification en basse fréquence.
- 747-7-3 (1991) Section trois: Spécification particulière cadre pour les transistors bipolaires de commutation.
- 747-7-4 (1991) Section quatre: Spécification particulière cadre pour les transistors bipolaires à température de boîtier spécifiée pour amplification en haute fréquence.
- 747-8 (1984) Huitième partie: Transistors à effet de champ.
Amendement 1 (1991).
Amendement 2 (1993).
- 747-8-1 (1987) Section un: Spécification particulière cadre pour les transistors à effet de champ à grille unique jusqu'à 5 W et 1 GHz.
- 747-8-2 (1993) Section deux: Spécification particulière cadre pour les transistors à effet de champ à température de boîtier spécifiée pour applications en amplificateurs de puissance.
- 747-8-3 (1995) Section 3: Spécification particulière cadre pour les transistors à effet de champ, à température de boîtier spécifiée, pour applications en commutation.
- 747-10 (1991) Dixième partie: Spécification générique pour les dispositifs discrets et les circuits intégrés.
Amendement 1 (1995).
Amendement 2 (1996).
Amendement 3 (1996).
- 747-11 (1985) Onzième partie: Spécification intermédiaire pour les dispositifs discrets.
Amendement 1 (1991).
- 747-12 (1991) Partie 12: Spécification intermédiaire pour les dispositifs optoélectroniques.
- 747-12-1 (1995) Section 1: Spécification particulière cadre pour diodes électroluminescentes, diodes émettrices avec/sans fibres amorce pour systèmes et sous-systèmes à fibres optiques.
- 747-12-2 (1995) Section 2: Spécification particulière cadre pour module à diode laser avec fibres amorce pour systèmes et sous-systèmes à fibres optiques.
- 748: — Dispositifs à semiconducteurs. Circuits intégrés.
- 748-1 (1984) Première partie: Généralités.
Amendement 1 (1991).
Amendement 2 (1993).
Amendement 3 (1995).
- 748-2 (1985) Deuxième partie: Circuits intégrés digitaux.
Amendement 1 (1991).
Amendement 2 (1993).

(suite)

IEC publications prepared by Technical Committee No. 47 (continued)

- 747-6 (1983) Part 6: Thyristors.
Amendment 1 (1991).
Amendment 2 (1994).
- 747-6-1 (1989) Section One: Blank detail specification for reverse blocking triode thyristors, ambient and case-rated, up to 100 A.
- 747-6-2 (1991) Section Two: Blank detail specification for bi-directional triode thyristors (triacs), ambient or case-rated temperature, up to 100 A.
- 747-6-3 (1993) Section Three: Blank detail specification for reverse blocking triode thyristors, ambient and case-rated, for currents greater than 100 A.
- 747-7 (1988) Part 7: Bipolar transistors.
Amendment 1 (1991).
Amendment 2 (1994).
- 747-7-1 (1989) Section One: Blank detail specification for ambient-rated bipolar transistors for low and high-frequency amplification.
- 747-7-2 (1989) Section Two: Blank detail specification for case-rated bipolar transistors for low-frequency amplification.
- 747-7-3 (1991) Section Three: Blank detail specification for bipolar transistors for switching applications.
- 747-7-4 (1991) Section Four: Blank detail specification for case-rated bipolar transistors for high-frequency amplification.
- 747-8 (1984) Part 8: Field-effect transistors.
Amendment 1 (1991).
Amendment 2 (1993).
- 747-8-1 (1987) Section One: Blank detail specification for single-gate field-effect transistors up to 5 W and 1 GHz.
- 747-8-2 (1993) Section Two: Blank detail specification for field-effect transistors for case-rated power amplifier applications.
- 747-8-3 (1995) Section 3: Blank detail specification for case-rated field-effect transistors for switching applications.
- 747-10 (1991) Part 10: Generic specification for discrete devices and integrated circuits.
Amendment 1 (1995).
Amendment 2 (1996).
Amendment 3 (1996).
- 747-11 (1985) Part 11: Sectional specification for discrete devices.
Amendment 1 (1991).
- 747-12 (1991) Part 12: Sectional specification for optoelectronic devices.
- 747-12-1 (1995) Section 1: Blank detail specification for light emitting/infrared emitting diodes with/without pigtail for fibre optic systems and sub-systems.
- 747-12-2 (1995) Section 2: Blank detail specification for laser diode modules with pigtail for fibre optic systems and sub-systems.
- 748: — Semiconductor devices. Integrated circuits.
- 748-1 (1984) Part 1: General.
Amendment 1 (1991).
Amendment 2 (1993).
Amendment 3 (1995).
- 748-2 (1985) Part 2: Digital integrated circuits.
Amendment 1 (1991).
Amendment 2 (1993).

(continued)

Publications de la CEI préparées par le Comité d'Etudes n° 47 (suite)

- 748-2-1 (1991) Section deux – Spécification particulière cadre pour les portes bipolaires à circuits intégrés digitaux monolithiques (non valable pour les réseaux logiques prédéfinis).
- 748-2-2 (1992) Section deux – Spécification de famille pour les circuits intégrés numériques HCMOS, séries 54/74 HC, 54/74 HCT, 54/74 HCU.
Amendement 1 (1994).
- 748-2-3 (1992) Section trois – Spécification particulière cadre pour les circuits intégrés numériques HCMOS, séries 54/74 HC, 54/74 HCT, 54/74 HCU.
- 748-2-4 (1992) Section quatre – Spécification de famille pour les circuits intégrés numériques MOS complémentaires, séries 4 000 B et 4 000 UB.
- 748-2-5 (1992) Section cinq – Spécification particulière cadre pour les circuits intégrés numériques MOS complémentaires (séries 4 000 B et 4 000 UB).
- 748-2-6 (1991) Section six – Spécification particulière cadre pour les microprocesseurs à circuits intégrés.
- 748-2-7 (1992) Section sept – Spécification particulière cadre pour les mémoires bipolaires à lecture seule programmables par fusion à circuits intégrés.
- 748-2-8 (1993) Section huit – Spécification particulière cadre pour les mémoires à circuits intégrés, à lecture-écriture, à fonctionnement statique.
- 748-2-9 (1994) Section 9: Spécification particulière cadre pour les mémoires mortes MOS effaçables aux UV et programmables électriquement.
- 748-2-10 (1994) Section 10: Spécification particulière cadre pour les mémoires à circuits intégrés à lecture-écriture, à fonctionnement dynamique
- 748-3 (1986) Troisième partie: Circuits intégrés analogiques.
Amendement 1 (1991).
Amendement 2 (1994).
- 748-3-1 (1991) Section un: Spécification particulière cadre pour les amplificateurs opérationnels intégrés monolithiques.
- 748-4 (1987) Quatrième partie: Circuits intégrés d'interface.
Amendement 1 (1991).
Amendement 2 (1994).
- 748-4-1 (1993) Partie 4: Circuits intégrés d'interface – Section 1: Spécification particulière cadre pour les convertisseurs linéaires numériques-analogiques.
- 748-4-2 (1993) Partie 4: Circuits intégrés d'interface – Section 2: Spécification particulière cadre pour les convertisseurs linéaires analogiques-numériques.
- 748-11 (1990) Onzième partie: Spécification intermédiaire pour les circuits intégrés à semiconducteurs à l'exclusion des circuits hybrides.
Amendement 1 (1995).
- 748-11-1 (1992) Onzième partie: Section un: Examen visuel interne pour les circuits intégrés à semi-conducteurs à l'exclusion des circuits hybrides.
- 748-20 (1988) Vingtième partie: Spécification générique pour les circuits intégrés à couches et les circuits intégrés hybrides à couches.
Amendement 1 (1995).
- 748-20-1 (1994) Section 1: Exigences pour l'examen visuel interne.
- 748-21 (1991) Partie 21: Spécification intermédiaire pour les circuits intégrés à couches et les circuits intégrés hybrides à couches sur la base des procédures d'homologation.
- 748-21-1 (1991) Section un: Spécification particulière cadre pour les circuits intégrés à couches et les circuits intégrés hybrides à couches sur la base des procédures d'homologation.

(suite)

IEC publications prepared by Technical Committee No. 47 (continued)

- 748-2-1 (1991) Section two – Blank detail specification for bipolar monolithic digital integrated circuit gates (excluding uncommitted logic arrays).
- 748-2-2 (1992) Section two – Family specification for HCMOS digital integrated circuits, series 54/74 HC, 54/74 HCT, 54/74 HCU.
Amendment 1 (1994).
- 748-2-3 (1992) Section three – Blank detail specification for HCMOS digital integrated circuits, series 54/74 HC, 54/74 HCT, 54/74 HCU.
- 748-2-4 (1992) Section four – Family specification for complementary MOS digital integrated circuits, series 4 000 B and 4 000 UB.
- 748-2-5 (1992) Section five – Blank detail specification for complementary MOS digital integrated circuits (series 4 000 B and 4 000 UB).
- 748-2-6 (1991) Section six – Blank detail specification for micro-processor integrated circuits.
- 748-2-7 (1992) Section seven – Blank detail specification for integrated circuit fusible-link programmable bipolar read-only memories.
- 748-2-8 (1993) Section eight – Blank detail specification for integrated circuit static read/write memories.
- 748-2-9 (1994) Section 9: Blank detail specification for MOS ultra-violet light erasable electrically programmable read-only memories.
- 748-2-10 (1994) Section 10: Blank detail specification for integrated circuit dynamic read/write memories.
- 748-3 (1986) Part 3: Analogue integrated circuits.
Amendment 1 (1991).
Amendment 2 (1994).
- 748-3-1 (1991) Section One: Blank detail specification for monolithic integrated operational amplifiers.
- 748-4 (1987) Part 4: Interface integrated circuits.
Amendment 1 (1991).
Amendment 2 (1994).
- 748-4-1 (1993) Part 4: Interface integrated circuits – Section 1: Blank detail specification for linear digital-to-analogue converters (DAC).
- 748-4-2 (1993) Part 4: Interface integrated circuits – Section 2: Blank detail specification for linear analogue-to-digital converters (ADC).
- 748-11 (1990) Part 11: Sectional specification for semiconductor integrated circuits excluding hybrid circuits.
Amendment 1 (1995).
- 748-11-1 (1992) Part 11: Section one: Internal visual examination for semiconductor integrated circuits excluding hybrid circuits.
- 748-20 (1988) Part 20: Generic specification for film integrated circuits and hybrid film integrated circuits.
Amendment 1 (1995).
- 748-20-1 (1994) Section 1: Requirements for internal visual examination.
- 748-21 (1991) Part 21: Sectional specification for film integrated circuits and hybrid film integrated circuits on the basis of qualification approval procedures.
- 748-21-1 (1991) Section One: Blank detail specification for film integrated circuits and hybrid film integrated circuits on the basis of qualification approval procedures.

(continued)

**Publications de la CEI préparées
par le Comité d'Etudes n° 47 (suite)**

- 748-22 (1992) Vingt-deuxième partie: Spécification intermédiaire pour les circuits intégrés à couches et les circuits intégrés hybrides à couches sur la base des procédures d'agrément de savoir-faire.
- 748-22-1 (1991) Section un – Spécification particulière cadre pour les circuits intégrés à couches et les circuits intégrés hybrides à couches sur la base des procédures d'agrément de savoir-faire.
- 749 (1996) Dispositifs à semiconducteurs. Essais mécaniques et climatiques.
- 1739 (1996) Circuits intégrés – Procédures pour l'agrément d'une ligne de fabrication et la gestion de la qualité.

**IEC publications prepared
by Technical Committee No. 47 (continued)**

- 748-22 (1992) Part 22: Sectional specification for film integrated circuits and hybrid film integrated circuits on the basis of the capability approval procedure.
- 748-22-1 (1991) Section one – Blank detail specification for film integrated circuits and hybrid film integrated circuits on the basis of the capability approval procedures.
- 749 (1996) Semiconductor devices. Mechanical and climatic test methods.
- 1739 (1996) Integrated circuits – Procedures for manufacturing line approval and quality management.

ICS 31.080.01
